

ZD3.9

硅外延平面稳压二极管芯片 (4")

■用途:

*用于稳压电路

■特征:

*稳压范围 3.9V(±5%)

*耗散功率 0.5W

*适用于 SOT-23 封装

*有效图形数: 56150 只

■芯片示意图



■芯片结构

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 芯片尺寸 | 350μm×350μm |
| 压焊区尺寸 | 180μm×180μm |
| 芯片厚度 | 180±10μm |
| 锯片槽宽度 | 50μm |
| 金属层 | 正面: Al 2.3±0.2μm 背面: Au 1.4±0.2μm |

■电特性(Ta=25℃)

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 典型值 | 单位 |
|-------|-----------------|------------------------|-----|-----|-----|----|
| 稳压值 | V _Z | I _Z =5.0mA | 3.7 | 4.1 | 3.9 | V |
| 输出阻抗 | Z _{ZT} | I _{ZT} =5.0mA | | 90 | | Ω |
| | Z _{ZK} | I _{ZK} =1.0mA | | 600 | | Ω |
| 反向漏电流 | I _R | V _R =1.0V | | 3.0 | | μA |
| 正向电压 | V _F | I _F =10mA | | 0.9 | | V |